



**Höchstzulässige Werte / Maximum rated values**

**Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		$V_{CES}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80\text{ °C}$	$I_{C,nom.}$	75	A
	$T_C = 25\text{ °C}$	$I_C$	170	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80\text{ °C}$	$I_{CRM}$	150	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C=25\text{ °C}, \text{ Transistor}$	$P_{tot}$	690	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		$I_F$	75	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	$I_{FRM}$	150	A
Grenzlastintegral der Diode $I^2t$ - value, Diode	$V_R = 0V, t_p = 10ms, T_{vj} = 125\text{ °C}$	$I^2t$	1,19	$kA^2s$
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}, t = 1\text{ min.}$	$V_{ISOL}$	2,5	kV

**Charakteristische Werte / Characteristic values**

**Transistor / Transistor**

**min. typ. max.**

Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 75A, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$V_{CE\ sat}$	-	2,1	2,6	V
	$I_C = 75A, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 125\text{ °C}$		-	2,4	2,9	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 3mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15V...+15V$	$Q_G$	-	0,8	-	$\mu C$
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1MHz, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	$C_{ies}$	-	5,1	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1MHz, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	$C_{res}$	-	0,33	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$I_{CES}$	-	3	92	$\mu A$
	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125\text{ °C}$		-	300	-	$\mu A$
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0V, V_{GE} = 20V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$I_{GES}$	-	-	400	nA

prepared by: Mark Münzer	date of publication: 9.9.1999
approved by: M. Hierholzer	revision: 2



**Charakteristische Werte / Characteristic values**

Transistor / Transistor		min.	typ.	max.		
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V$	$t_{d,on}$	-	0,05	-	$\mu s$
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 10\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$			0,06	-	$\mu s$
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V$	$t_r$	-	0,05	-	$\mu s$
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 10\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$			0,05	-	$\mu s$
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V$	$t_{d,off}$	-	0,3	-	$\mu s$
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 10\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$			0,35	-	$\mu s$
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V$	$t_f$	-	0,05	-	$\mu s$
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 10\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$			0,07	-	$\mu s$
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 10\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 60nH$	$E_{on}$	-	7,5	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 10\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 60nH$	$E_{off}$	-	9	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_F \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V, R_G = 10\Omega$ $T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 900V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$I_{SC}$	-	540	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{sCE}$	-	40	-	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse – Chip module lead resistance, terminals – chip	$T_C = 25^\circ C$	$R_{CC+EE}$	-	1,0	-	m $\Omega$

**Charakteristische Werte / Characteristic values**

Diode / Diode		min.	typ.	max.		
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 75A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	$V_F$	-	1,8	2,3	V
	$I_F = 75A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$			1,7	2,2	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 75A, - di_F/dt = 2000A/\mu sec$	$I_{RM}$	-	85	-	A
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$			105	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 75A, - di_F/dt = 2000A/\mu sec$	$Q_r$	-	9	-	$\mu As$
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$			16,5	-	$\mu As$
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 75A, - di_F/dt = 2000A/\mu sec$	$E_{rec}$	-	3	-	mWs
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$			6,2	-	mWs



**Thermische Eigenschaften / Thermal properties**

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	$R_{thJC}$	-	-	0,18	K/W
	Diode/Diode, DC		-	-	0,5	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{\text{Ictosite}} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$	$R_{thCK}$	-	0,05	-	K/W
Höchstzulässige Sperschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj}$	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		$T_{op}$	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$	-40	-	150	°C

**Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties**

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix					
Innere Isolation internal insulation				AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	
Kriechstrecke creepage distance				20	mm
Luftstrecke clearance				11	mm
CTI comperative tracking index				275	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	terminals M6	M1	3	6	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M5	M2	2,5	5	Nm
Gewicht weight		G		250	g

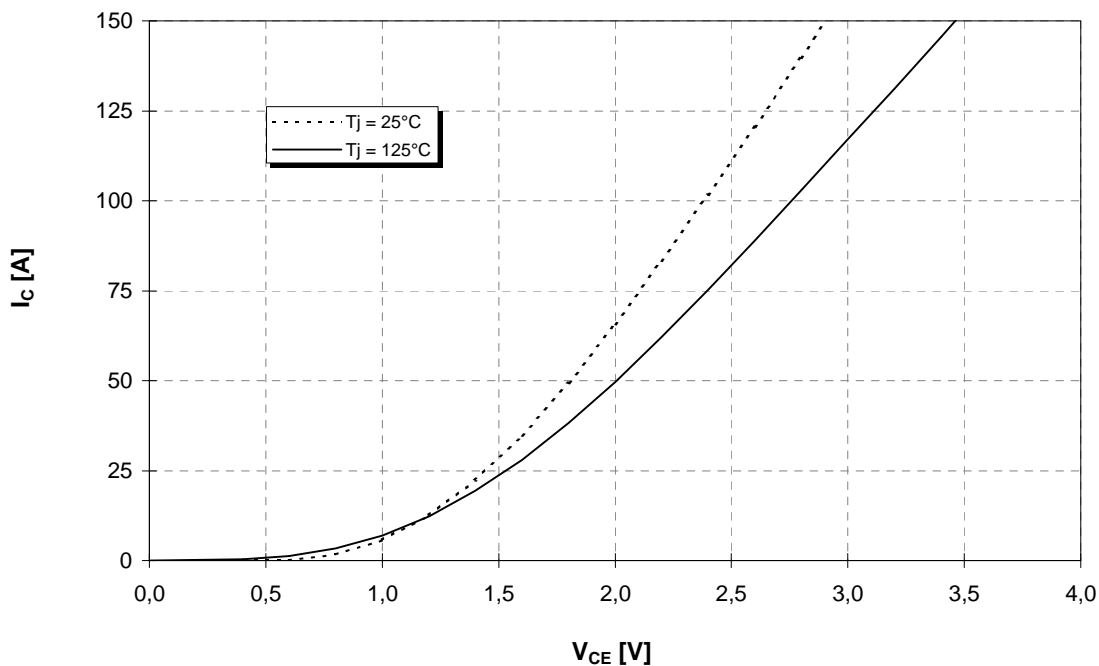
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



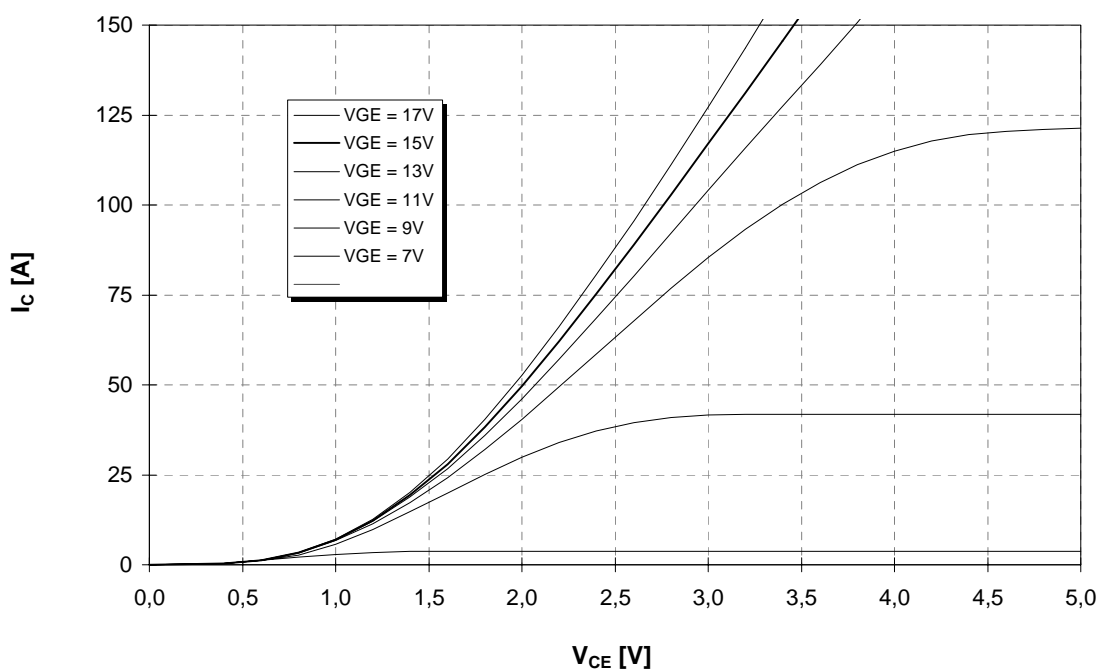
**Ausgangskennlinie (typisch)**  
**Output characteristic (typical)**

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15V$



**Ausgangskennlinienfeld (typisch)**  
**Output characteristic (typical)**

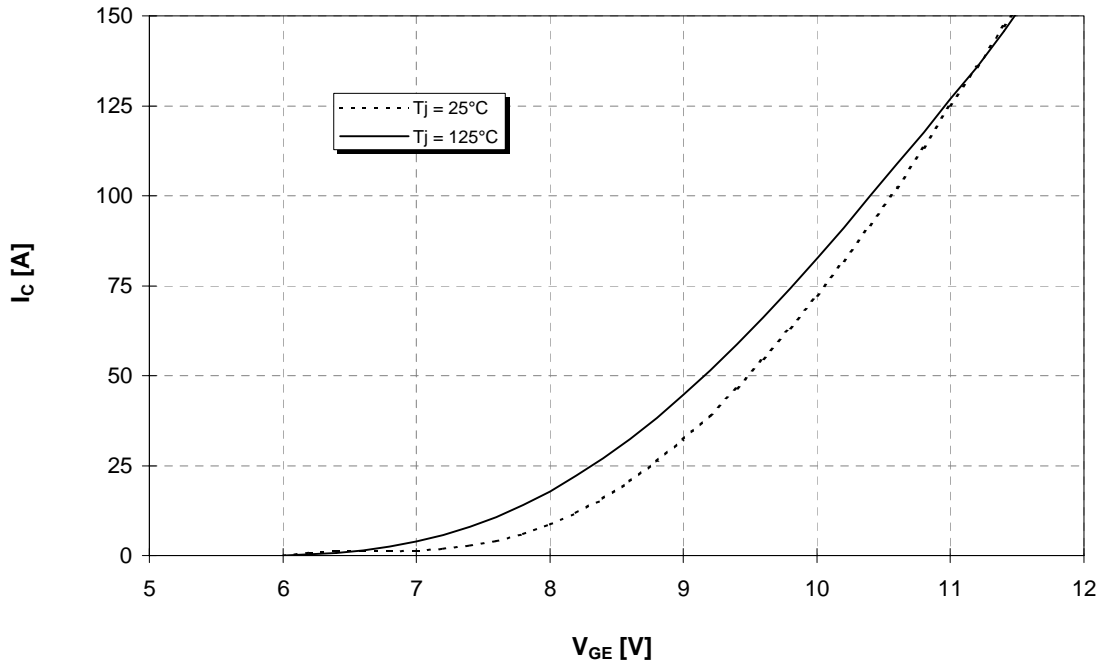
$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 125^\circ C$





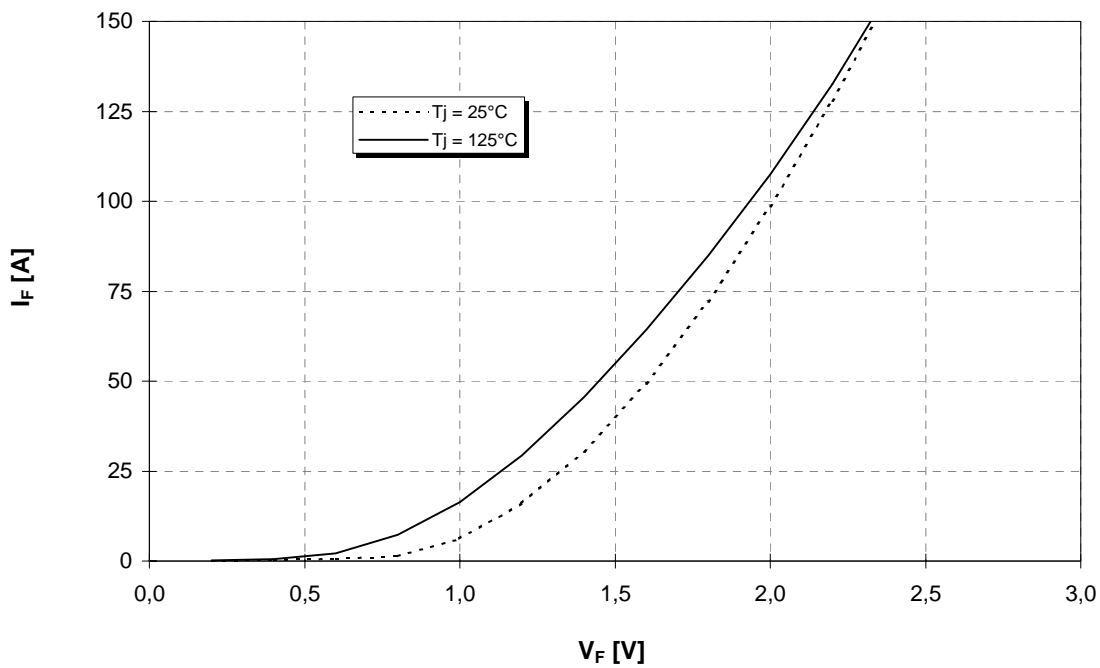
Übertragungscharakteristik (typisch)  
Transfer characteristic (typical)

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20V$



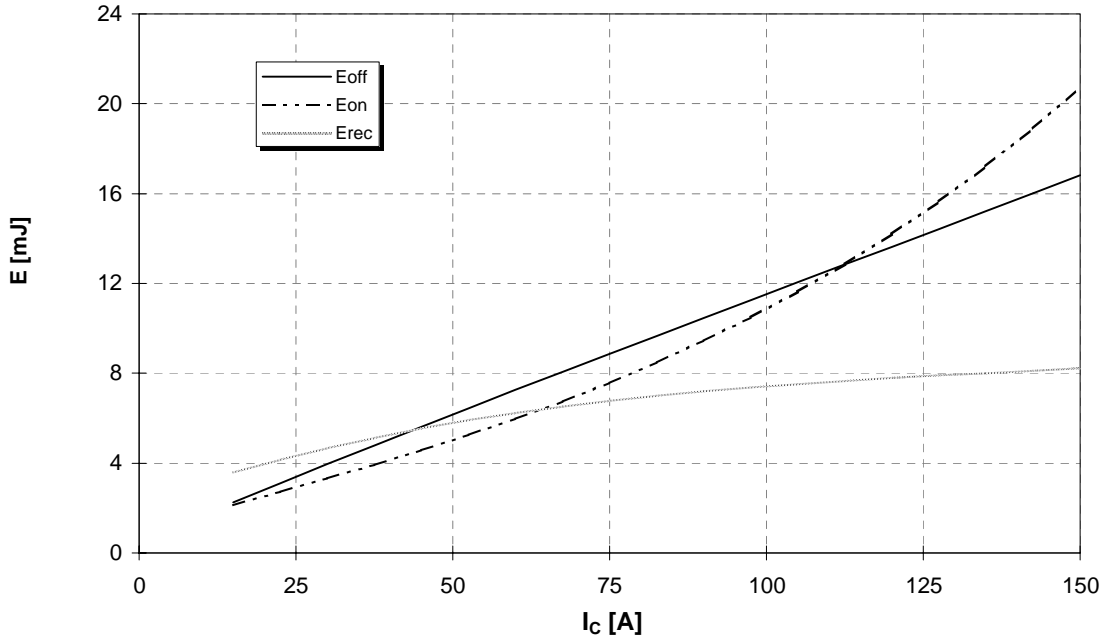
Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)  
Forward characteristic of inverse diode (typical)

$I_F = f(V_F)$

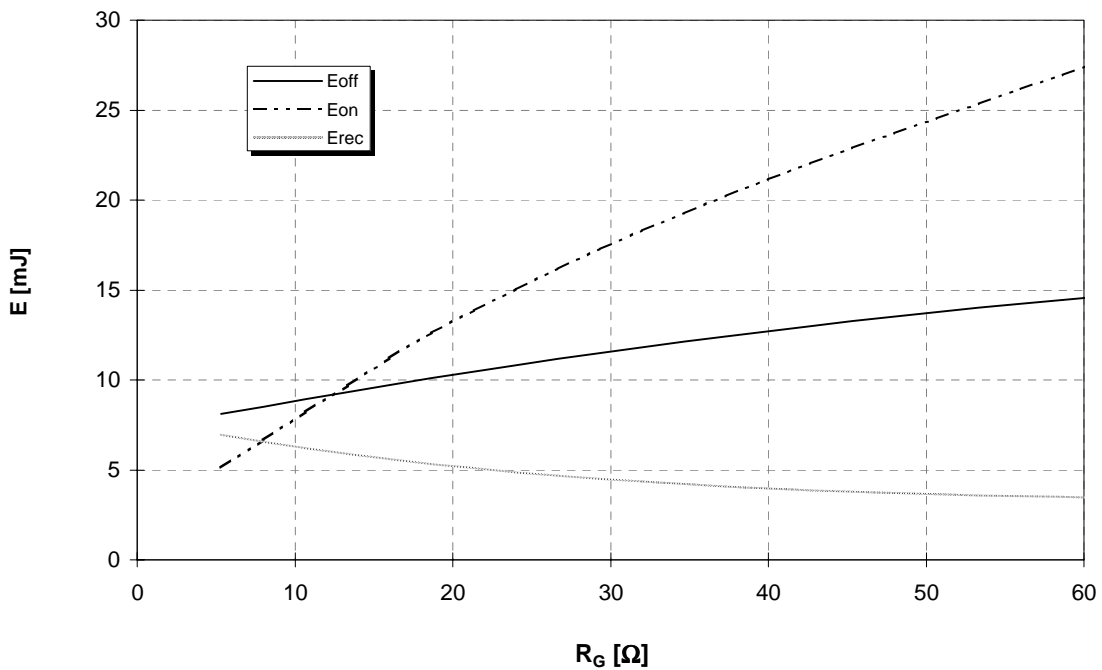




**Schaltverluste (typisch)     $E_{on} = f(I_C)$  ,  $E_{off} = f(I_C)$  ,  $E_{rec} = f(I_C)$**   
**Switching losses (typical)     $V_{GE}=15V$  ,  $R_{gon} = R_{goff}=10\ \Omega$  ,  $V_{CE} = 600V$  ,  $T_j = 125^\circ C$**



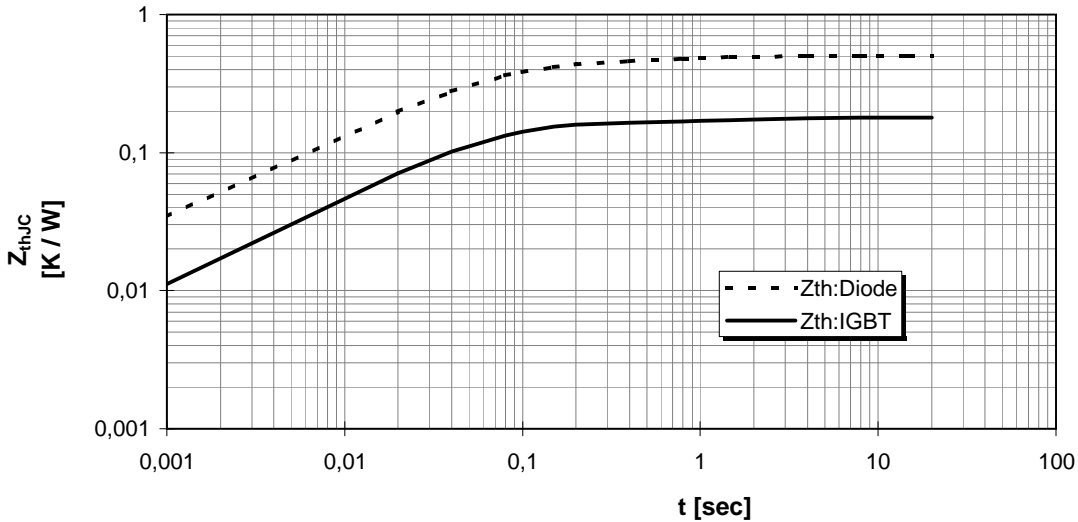
**Schaltverluste (typisch)     $E_{on} = f(R_G)$  ,  $E_{off} = f(R_G)$  ,  $E_{rec} = f(R_G)$**   
**Switching losses (typical)     $V_{GE}=15V$  ,  $I_C = 75A$  ,  $V_{CE} = 600V$  ,  $T_j = 125^\circ C$**





**Transienter Wärmewiderstand**  
**Transient thermal impedance**

$$Z_{thJC} = f(t)$$

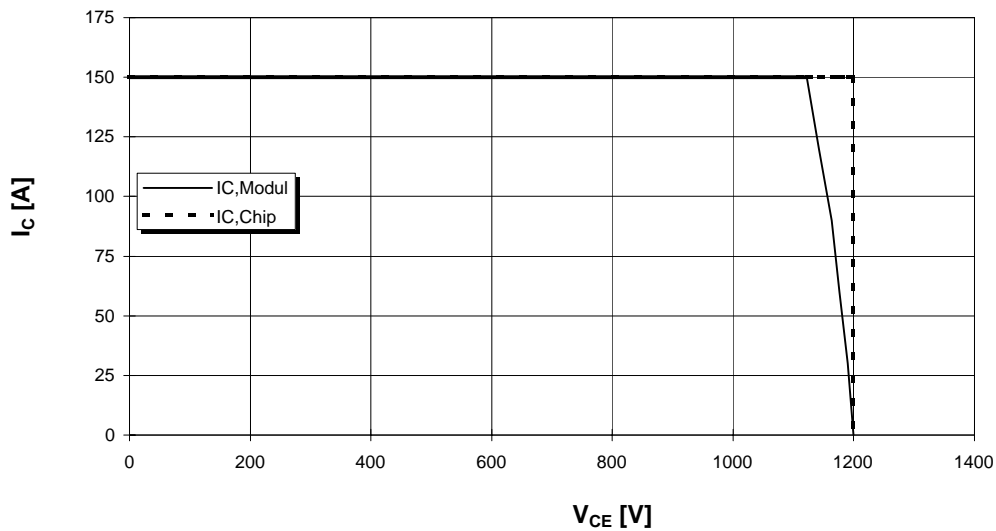


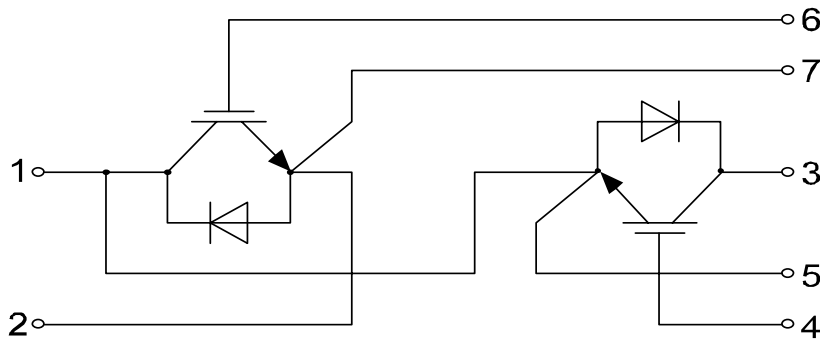
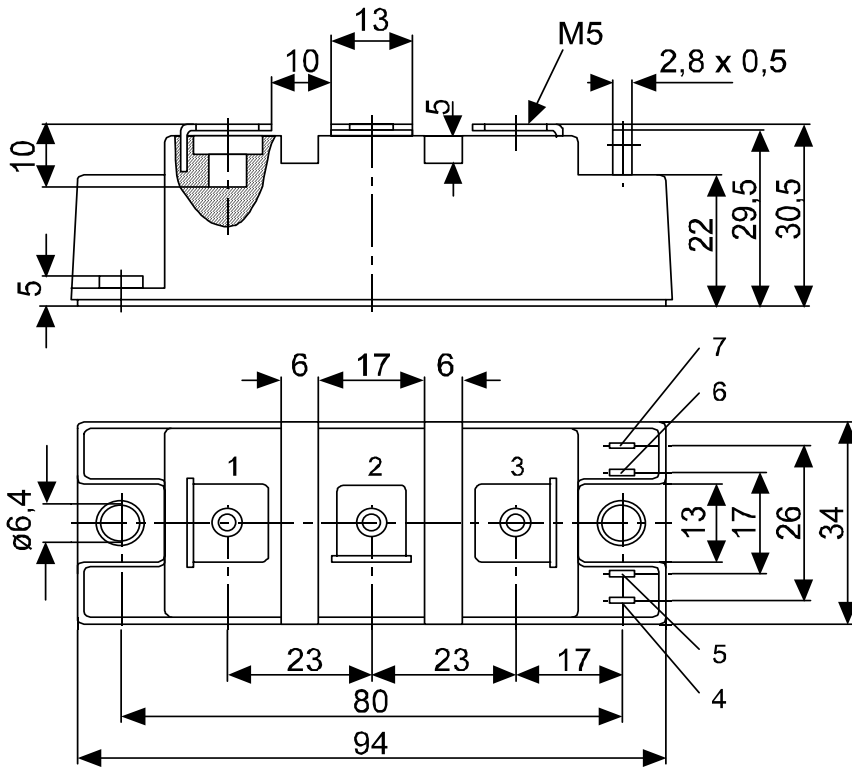
i	1	2	3	4
$r_i$ [K/kW] : IGBT	20,13	60,93	79,4	19,54
$\tau_i$ [sec] : IGBT	0,002	0,03	0,066	1,655
$r_i$ [K/kW] : Diode	65,43	173,31	189,08	72,18
$\tau_i$ [sec] : Diode	0,002	0,03	0,072	0,682

**Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)**

**Reverse bias safe operation area (RBSOA)**

$V_{GE} = 15V, R_g = 10 \text{ Ohm}, T_{vj} = 125^\circ C$







Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)